

96%効率 1.5Aスイッチ付き 同期式 ブースト・コンバータ

特長

- 効率96%の同期式ブースト・コンバータ
 - 出力電流200mA (入力電圧0.9V時)
 - 出力電流500mA (入力電圧1.8V時)
- 入力電圧が標準出力電圧を越えた時でも出力電圧はレギュレーションを続行
- デバイス静止時電流: 25 μ A (Typ)
- 入力電圧範囲: 0.9V~6.5V
- 最大5.5Vの可変出力電圧、及び固定出力電圧
- パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
- ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
- 低EMIコンバータ (アンチリング・スイッチ内蔵)
- シャットダウン時負荷を切り離し
- 過熱保護
- 小型10ピンQFNパッケージ (3mm x 3mm)

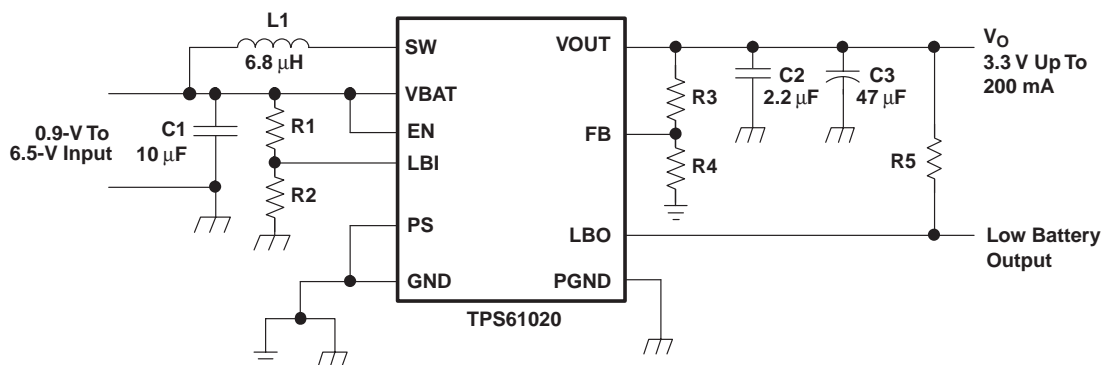
アプリケーション

- 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- カメラの白色LEDフラッシュ

概要

TPS6102xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用時セル電圧0.9Vから200mAを供給可能です。また、この製品は3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/500mAを生成するのもにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用しています。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードになります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることができ、その場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は1500mAに制限されています。

TPS6102xデバイスは、入力電圧が設定出力電圧を越えた時でも出力電圧のレギュレーション状態を保持します。出力電圧は外付けの抵抗デバイスによりプログラムされるか、もしくはチップ内部で固定になっています。コンバータはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルにすることができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから完全に切り離されます。低EMIモードはリングングを低減するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは3 \times 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供給されています。



SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI) が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ(日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したものです。資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。



静電気放電対策

静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。

AVAILABLE OUTPUT VOLTAGE OPTIONS⁽¹⁾

T _A	OUTPUT VOLTAGE DC/DC	PACKAGE MARKING	PACKAGE	PART NUMBER ⁽²⁾
40°C to 85°C	Adjustable	BDR	10-Pin QFN	TPS61020DRC
	3.0 V	BDS		TPS61024DRC
	3.3 V	BDT		TPS61025DRC
	5 V	BDU		TPS61027DRC

(1) その他の固定出力電圧バージョンについては弊社にお問い合わせください。

(2) DRCパッケージはテープ/リールでも供給できます。デバイス・タイプの末尾にRを付けてください(例、TPS61020DRCR)。個数はリール当たり3000個です。

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

	TPS6102X
Input voltage range on SW, VOUT, LBO, VBAT, PS, EN, FB, LBI	-0.3 V to 7 V
Operating virtual junction temperature range, T _J	-40°C to 150°C
Storage temperature range T _{stg}	-65°C to 150°C

(1) 絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

DISSIPATION RATINGS TABLE

PACKAGE	THERMAL RESISTANCE θ _{JA}	POWER RATING T _A ≤ 25°C	DERATING FACTOR ABOVE T _A = 25°C
DRC	48.7 °C/W	2054 mW	21 mW/°C

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

	MIN	NOM	MAX	UNIT
Supply voltage at VBAT, V _I	0.9		6.5	V
Operating free air temperature range, T _A	-40		85	°C
Operating virtual junction temperature range, T _J	-40		125	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

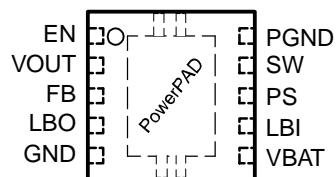
over recommended free-air temperature range and over recommended input voltage range (typical at an ambient temperature range of 25 °C) (unless otherwise noted)

DC/DC STAGE						
PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V _I	Minimum input voltage range for start-up	R _L = 120 Ω		0.9	1.2	V
	Input voltage range, after start-up		0.9		6.5	
V _O	TPS61020 output voltage range		1.8		5.5	V
V _{FB}	TPS61020 feedback voltage		490	500	510	mV
f	Oscillator frequency		480	600	720	kHz
I _{SW}	Switch current limit	V _{OUT} = 3.3 V	1200	1500	1800	mA
	Start-up current limit			0.4 × I _{SW}		
	SWN switch on resistance	V _{OUT} = 3.3 V		260		mΩ
	SWP switch on resistance	V _{OUT} = 3.3 V		290		mΩ
	Total accuracy (including line and load regulation)				3%	
	Line regulation				0.6%	
	Load regulation				0.6%	
Quiescent current	V _{BAT}	I _O = 0 mA, V _{EN} = V _{BAT} = 1.2 V, V _{OUT} = 3.3 V, T _A = 25°C		1	3	μA
	V _{OUT}			25	45	
Shutdown current		V _{EN} = 0 V, V _{BAT} = 1.2 V, T _A = 25°C		0.1	1	μA

CONTROL STAGE						
PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{UVLO}	Under voltage lockout threshold	V _{LBI} voltage decreasing		0.8		V
V _{IL}	LBI voltage threshold	V _{LBI} voltage decreasing	490	500	510	mV
	LBI input hysteresis			10		
	LBI input current	EN = V _{BAT} or GND		0.01	0.1	μA
V _{OL}	LBO output low voltage	V _O = 3.3 V, I _{OI} = 100 μA		0.04	0.4	V
	LBO output low current			100		
V _{Ikg}	LBO output leakage current	V _{LBO} = 7 V		0.01	0.1	μA
V _{IL}	EN, PS input low voltage				0.2 × V _{BAT}	V
V _{IH}	EN, PS input high voltage		0.8 × V _{BAT}			V
	EN, PS input current	Clamped on GND or V _{BAT}		0.01	0.1	
	Overtemperature protection			140		°C
	Overtemperature hysteresis			20		°C

PIN ASSIGNMENTS

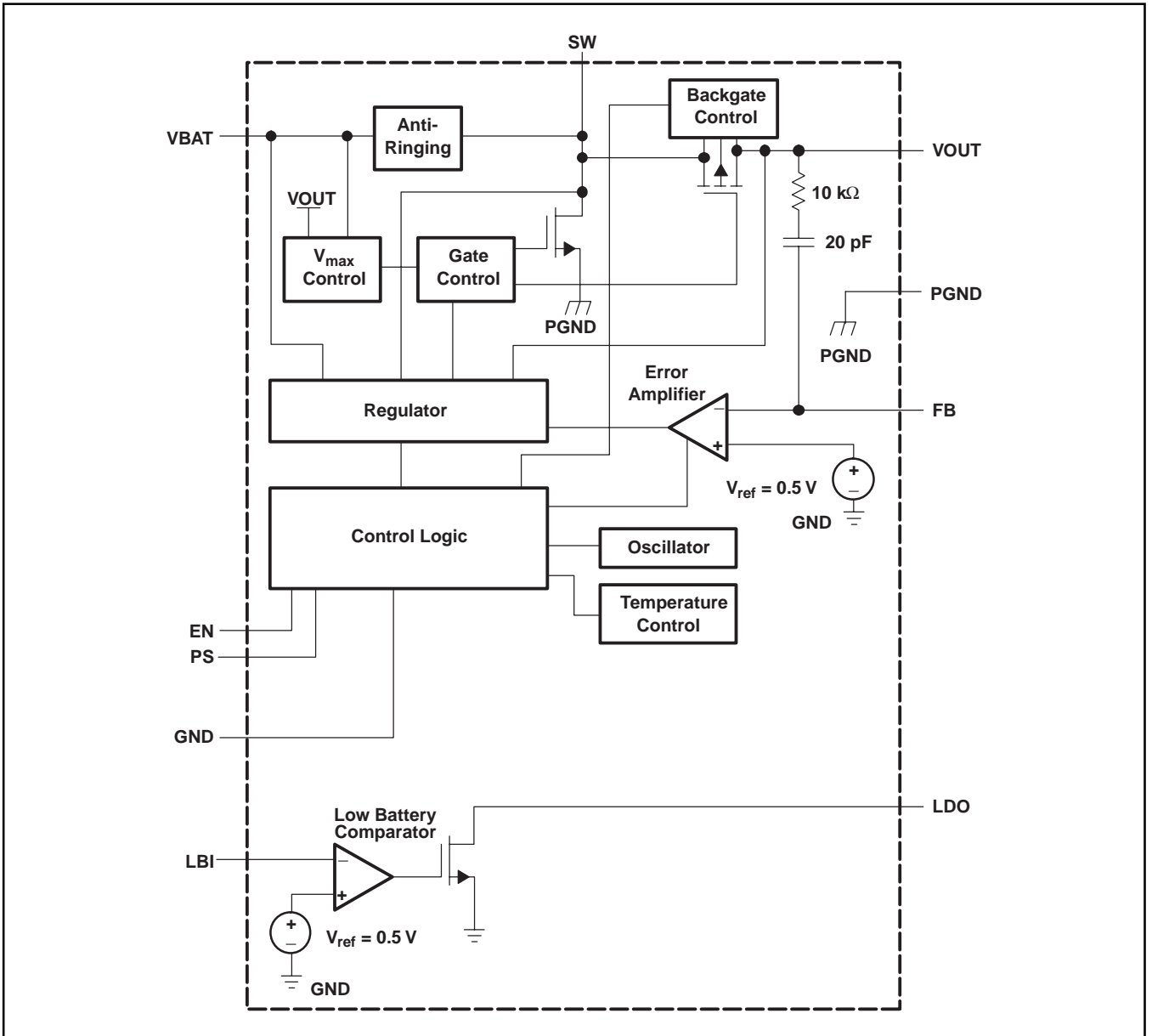
DRC PACKAGE
(TOP VIEW)



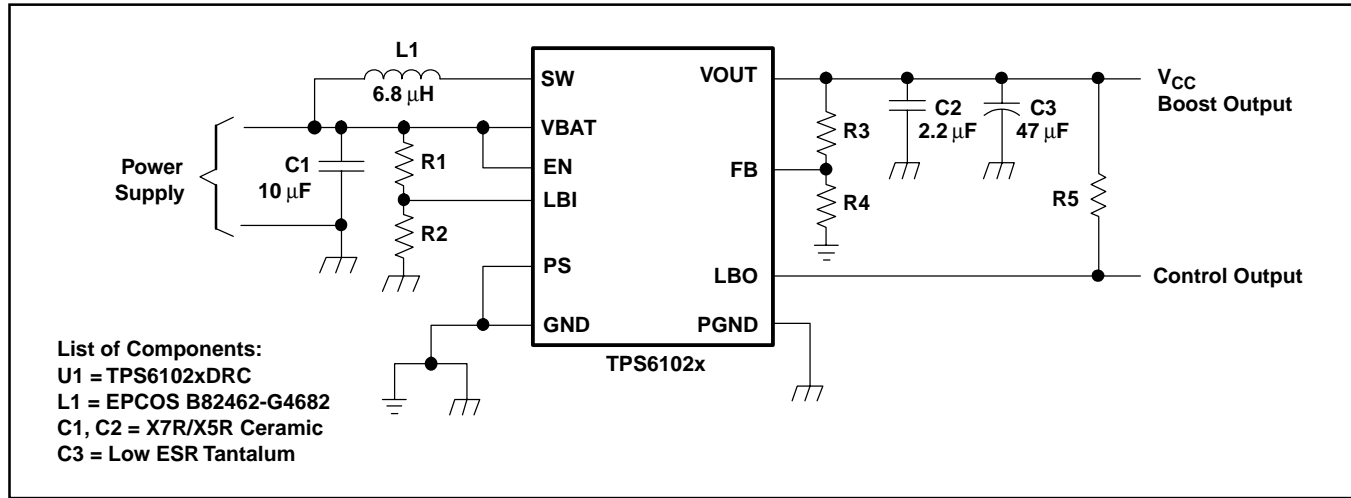
Terminal Functions

端子 NAME	NO.	I/O	機能
EN	1	I	イネーブル入力端子(1/VBATの場合イネーブル、0/GNDの場合ディスエーブル)
FB	3	I	可変出力電圧バージョンの電圧フィードバック端子
GND	5		コントロール/ロジック・グラウンド
LBI	7	I	ロー・バッテリー・コンパレータ入力端子(ENによりコンパレータはイネーブル)
LBO	4	O	ロー・バッテリー・コンパレータ出力端子(オープン・ドレイン)
PS	8	I	パワー・セーブ・モードのイネーブル/ディスエーブル(1/VBATの場合ディスエーブル、0/GNDの場合イネーブル)
SW	9	I	ブースト/整流スイッチ入力
PGND	10		電源グラウンド
VBAT	6	I	電源電圧
VOUT	2	O	ブースト・コンバータの出力端子
PowerPAD™			熱放散が適切に行われるようはんだ付けしなければなりません。PGNDに接続してください

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM (TPS61020)



PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

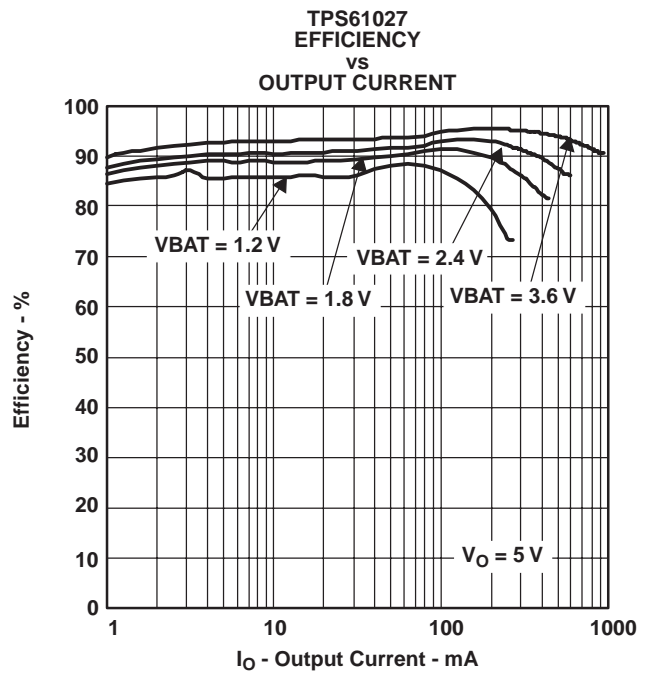
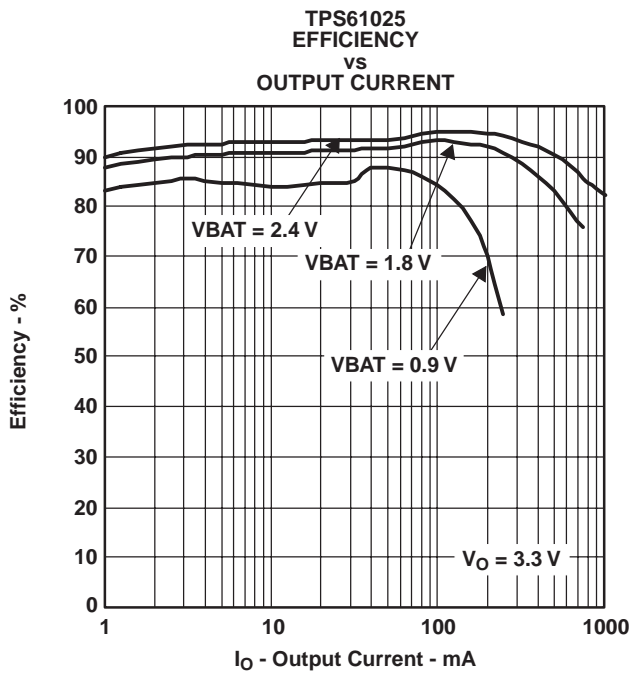
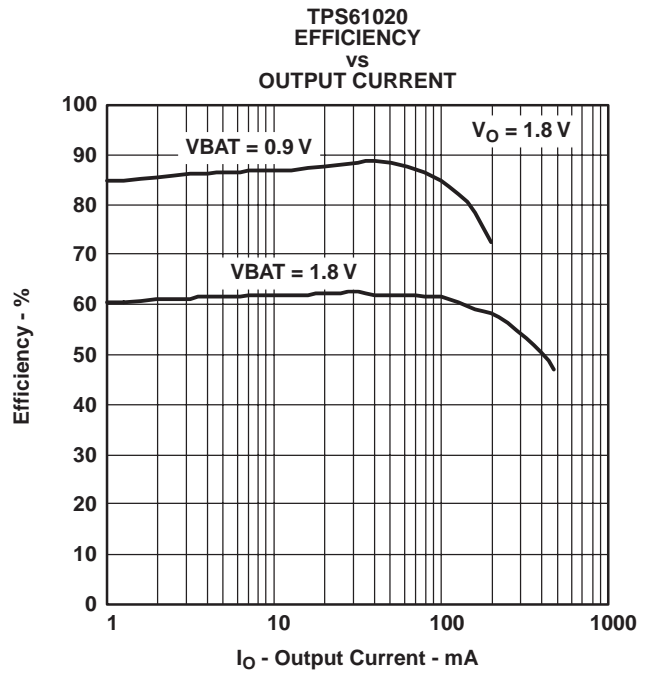
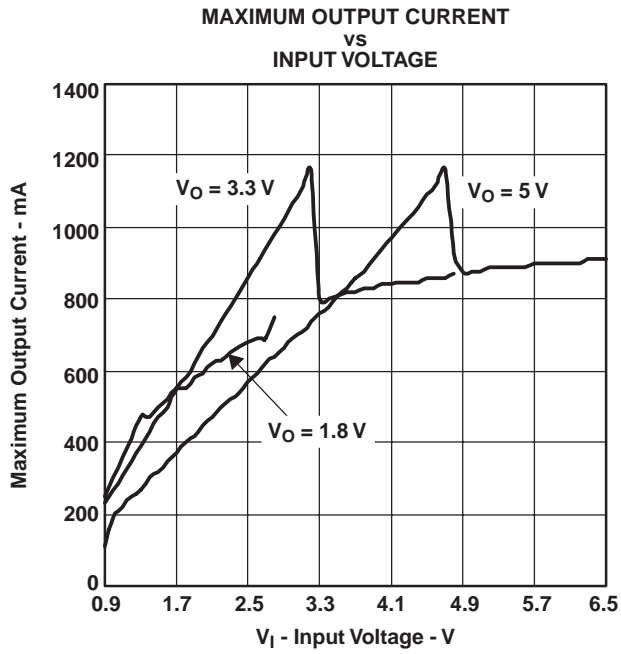


TYPICAL CHARACTERISTICS

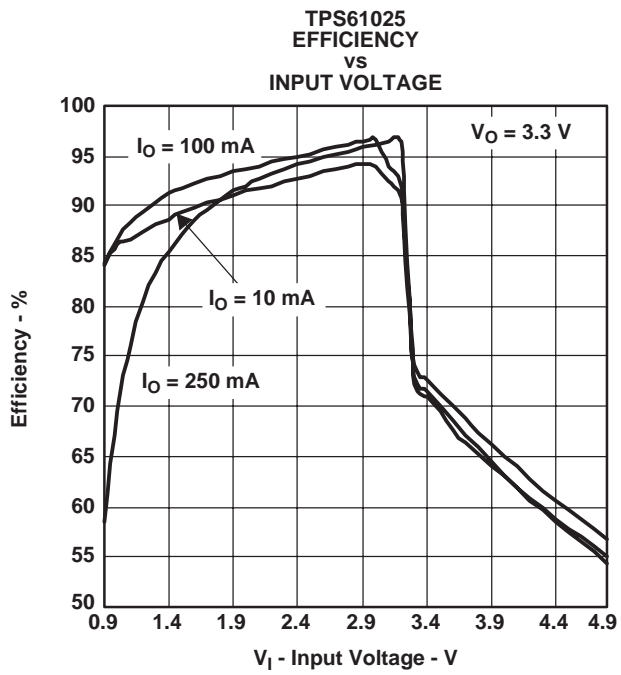
Table of Graphs

		FIGURE
Maximum output current	vs Input voltage	1
Efficiency	vs Output current (TPS61020)	2
	vs Output current (TPS61025)	3
	vs Output current (TPS61027)	4
	vs Input voltage (TPS61025)	5
	vs Input voltage (TPS61027)	6
	Output voltage	vs Output current (TPS61025)
	vs Output current (TPS61027)	8
No load supply current into VBAT	vs Input voltage	9
No load supply current into VOUT	vs Input voltage	10
Waveforms	Output voltage in continuous mode (TPS61025)	11
	Output voltage in continuous mode (TPS61027)	12
	Output voltage in power save mode (TPS61025)	13
	Output voltage in power save mode (TPS61027)	14
	Load transient response (TPS61025)	15
	Load transient response (TPS61027)	16
	Line transient response (TPS61025)	17
	Line transient response (TPS61027)	18
	Start-up after enable (TPS61025)	19
	Start-up after enable (TPS61027)	20

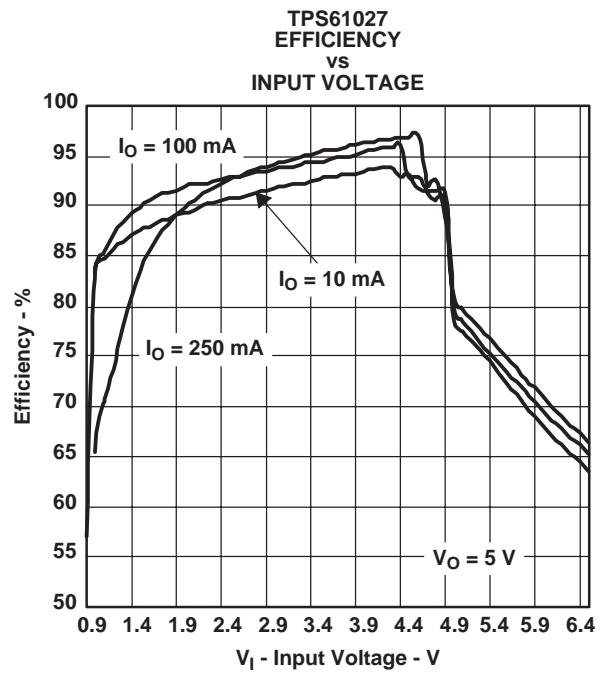
TYPICAL CHARACTERISTICS



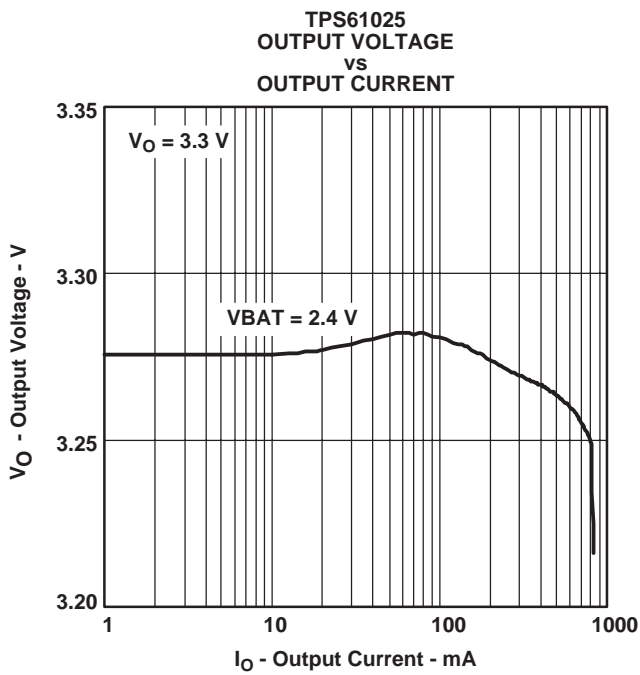
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)



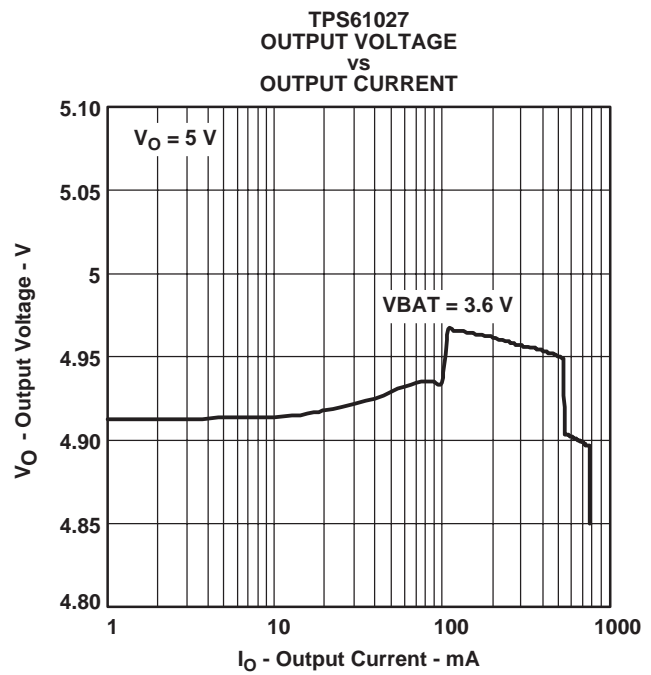
⊗5



⊗6



⊗7



⊗8

TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)

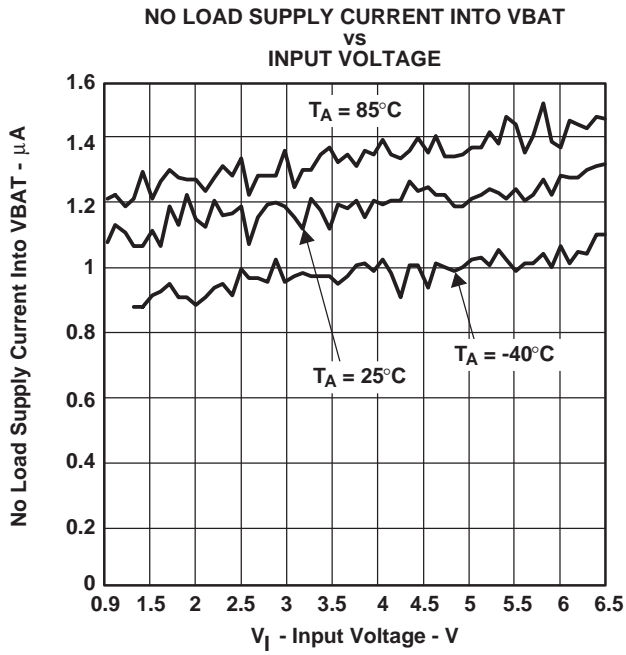


Figure 9

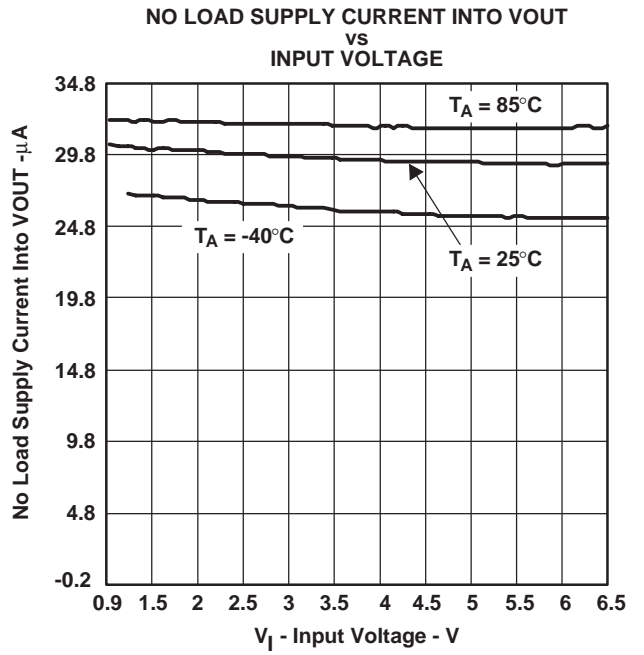


Figure 10

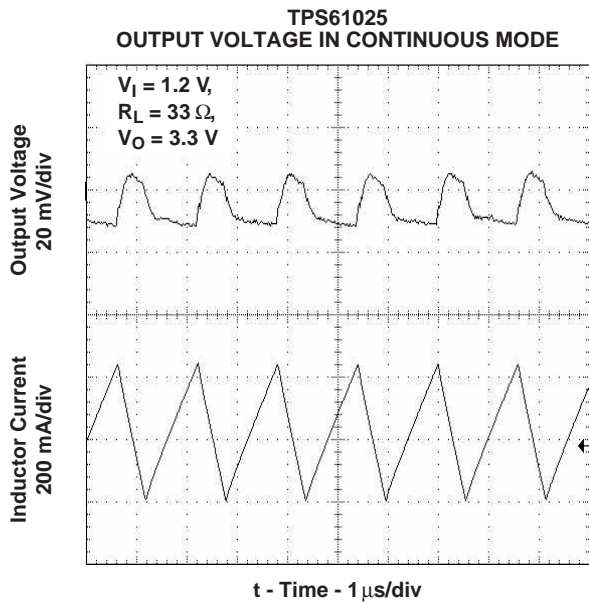


Figure 11

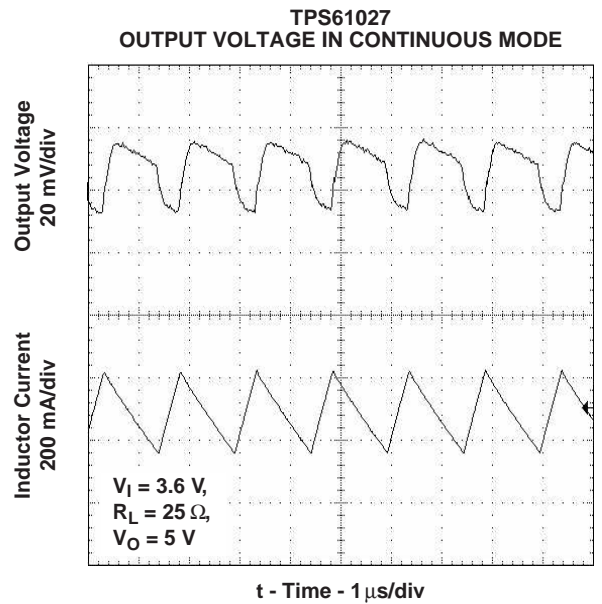


Figure 12

TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)

TPS61025
OUTPUT VOLTAGE IN POWER SAVE MODE

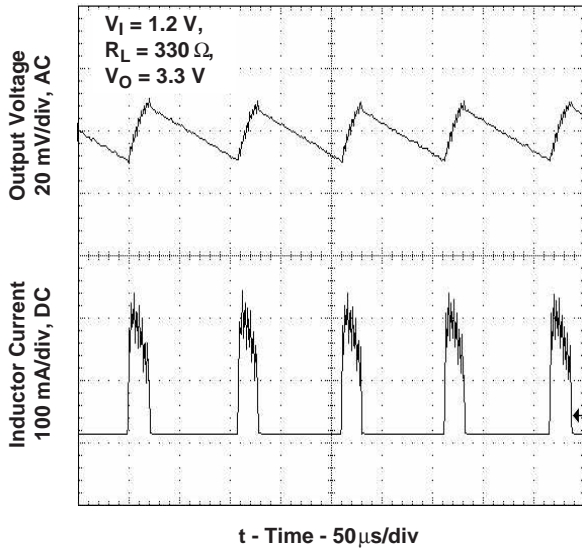


Figure 13

TPS61027
OUTPUT VOLTAGE IN POWER SAVE MODE

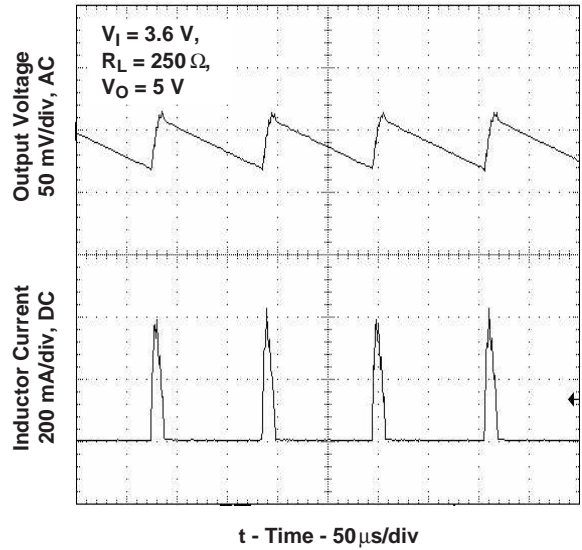


Figure 14

TPS61025
LOAD TRANSIENT RESPONSE

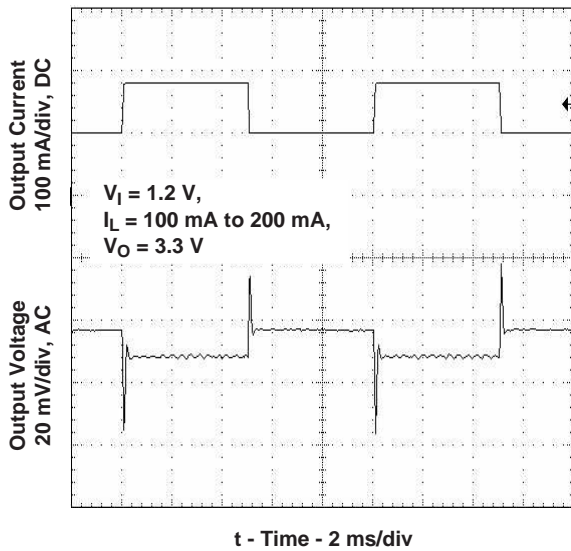


Figure 15

TPS61027
LOAD TRANSIENT RESPONSE

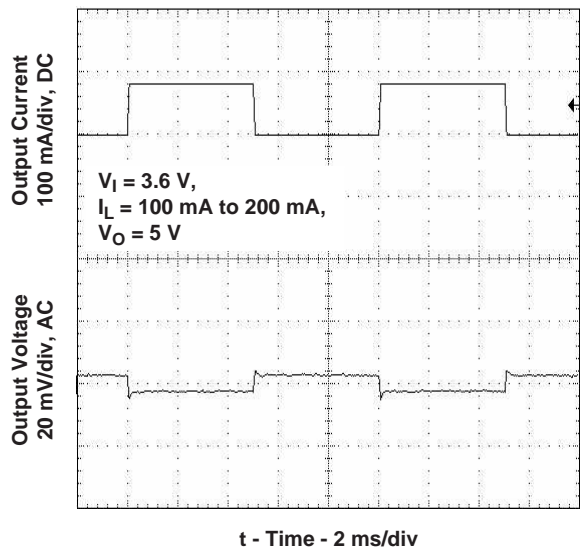
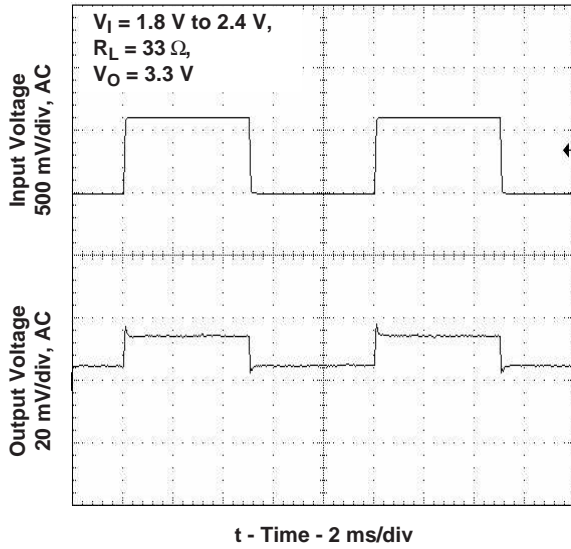


Figure 16

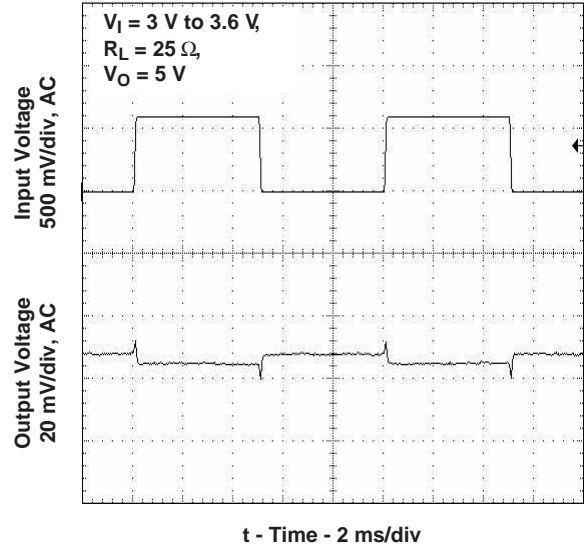
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)

TPS61025
LINE TRANSIENT RESPONSE



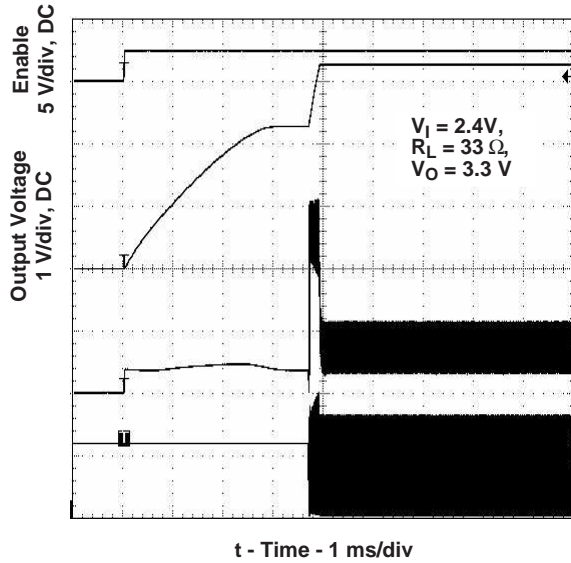
17

TPS61027
LINE TRANSIENT RESPONSE



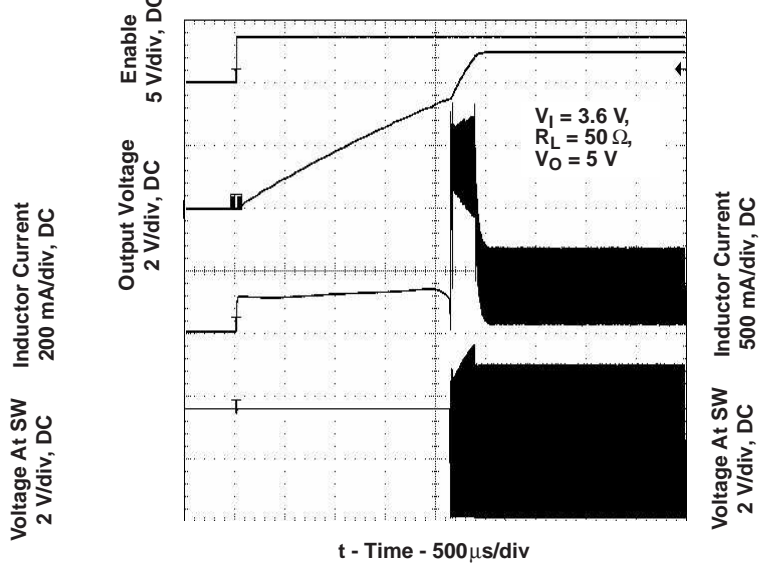
18

TPS61025
START-UP AFTER ENABLE



19

TPS61027
START-UP AFTER ENABLE



20

詳細説明

コントローラ回路

このデバイスは固定周波数の多重フィードフォワード・コントローラ・トポロジが基礎となっています。入力電圧、出力電圧、NMOSスイッチの電圧降下はモニタされ、レギュレータに直接送られます。従って、コンバータの動作状態が変化するとデューティ・サイクルを直接制御するため、コントロール・ループや誤差増幅器を通るゆっくりとした経路をとる必要はありません。誤差増幅器によって決まる、コントロール・ループは、小信号誤差を取り扱うことのみで十分です。FBピンのフィードバック電圧または固定電圧バージョンでは内部抵抗デバイダからの小信号誤差の入力は正確で安定した電圧を生成するため内部基準電圧と比較されます。

また、スイッチとインダクタを流れる最大電流を制限するためNMOSスイッチのピーク電流も検出されます。標準ピーク制限電流は1500mAに設定されています。内部の温度センサは過度の電力消費の場合にデバイスが過熱するのを防止します。

同期整流器

このデバイスは同期整流を実現するためNチャネル及びPチャネルMOSFETトランジスタを内蔵しています。一般に使用されているショットキー・ダイオードが低オン抵抗RDS(ON)のPMOSスイッチに置き換えられているため、電力変換効率は96%にも達します。NMOSスイッチの大電流によるグラウンドのシフトを避けるため、2つの別々のグラウンド・ピンが使用されています。すべてのコントロール機能に対する基準はGNDピンです。NMOSスイッチのソースはPGNDに接続されています。この両方のグラウンドはPCB上でGNDピンの近くで1点のみで接続しなければなりません。コンバータのシャットダウン時負荷を入力から切り離すため特別な回路が用いられています。従来の同期整流回路では、ハイサイドPMOSの寄生ダイオードがシャットダウン時順方向にバイアスされるため、バッテリーから出力に電流が流れてしまいます。しかし、このデバイスはハイサイドPMOSの寄生ダイオードのカソードを取り込み、レギュレータがイネーブルでない時(EN = "L" レベル)ソースから切り離す特別な回路を使用しています。

システム設計の技術者にとってこの機能の利点とは、コンバータのシャットダウン時バッテリーが消耗しないことです。確実にバッテリーをコンバータの出力から切り離すための設計上の追加部品は不要です。

ダウン・レギュレーション

一般的に、ブースト・コンバータは入力電圧より高い出力電圧のみをレギュレーションしますが、このデバイスの動作はこれとは異なります。例えば、総セル電圧が3.2Vの入力である2つの未使用のアルカリ・セルの場合、出力3.0Vをレギュレーションすることができます。他の例として、4.2Vの出力電圧をもつフル充電されたリチウム・イオン・セルから3.6Vの順方向電圧により白色LEDに電力供給することがあります。これらのアプリケーションを適切にコントロールするために、ダウン・コンバージョン・モードが使用されます。

入力電圧が出力電圧に達するか、または越えると、コンバータはダウン・コンバージョン・モードに切り換わります。このモードでは、コントロール回路はPMOSの整流動作を変更します。

NMOSによる昇圧スイッチが動作して入力電圧を昇圧してPMOS端子間の電圧降下を出力電圧をレギュレーションするのに必要とされる大きさに設定します。このことはコンバータの電力損失が増加することを意味します。熱考察でこのことを配慮しなければなりません。

デバイスのイネーブル

ENピンを“H”レベルにセットする事によりデバイスは動作するようになります。ENピンがGNDにセットされた場合デバイスはシャットダウン・モードになります。シャットダウン・モードでは、レギュレータはスイッチングを停止し、ロー・バッテリー・コンパレータを含むすべての内部コントロール回路はオフに切り換わり、負荷は入力から分離されます(“同期整流器”の項参照)。また、このことは、出力電圧はシャットダウン時入力電圧より下に低下することがあるということの意味しています。コンバータの起動時、バッテリーから大きなピーク電流が流れないようにするためデューティ・サイクルとピーク電流は起動時設定に制限されています。

低電圧ロックアウト

低電圧ロックアウト機能によりVBATピンの電源電圧が約0.8Vより下であるとデバイスの起動は停止されます。動作時及びバッテリーが放電している時、VBATピンの電圧が約0.8Vより下に低下すると、デバイスは自動的にシャットダウン・モードになります。この低電圧ロックアウト機能はコンバータの誤動作を防ぐために用いられます。

ソフトスタート

デバイスがイネーブルの時、内部の起動サイクルは最初のサイクルであるプリチャージ・フェーズで開始します。プリチャージ時、出力キャパシタが入力電圧に近い値に充電されるまで整流スイッチはオンになっています。整流スイッチはそのフェーズの間電流制限されています。この機能により、出力短絡状態での出力電流は制限されています。出力キャパシタを入力電圧まで充電した後、デバイスはスイッチングを開始します。入力電圧が1.4Vより下であると、デバイスは出力電圧が1.4Vに達するまで50%の固定デューティ・サイクルで動作します。その後、デューティ・サイクルは入出力電圧比により設定されます。出力電圧がその標準値に達するまで、ブースト・スイッチの制限電流は起動時バッテリーに大きなピーク電流が流れるのを回避するためその標準値の40%に設定されています。出力電圧に達するとすぐに、レギュレータはコントロールを開始し、スイッチの制限電流はもとの100%に設定されます。

パワー・セーブ・モード

PSピンは種々の動作モードを選択するのに使用できます。パワー・セーブをイネーブルにするには、PSピンを“L”レベルに設定しなければなりません。パワー・セーブ・モードは軽負荷時の効率を改善するのに使用されます。パワー・セーブ・モードでは、コンバータは出力電圧が設定スレッショールド電圧より下になった時のみ動作します。コンバータは1つまたはいくつかのパルスにより出力電圧を増加させ、出力電圧が設定スレッショールド電圧を越えると再びパワー・セーブ・モードになります。このパ

ワー・セーブ・モードはPSをVBATに接続することによりディスエーブルにすることができます。ダウン・コンバージョン・モードでは、パワー・セーブ・モードは常にアクティブであり、デバイスは軽負荷時に固定周波数動作になることはありません。

ロー・バッテリー検出回路 - LBI/LBO

ロー・バッテリー検出回路は、通常、バッテリー電圧を管理し、バッテリー電圧がユーザー設定のスレッシュホールド電圧より下に低下した時エラー・フラグを生成するのに使用されます。この機能はデバイスがイネーブルの場合にのみアクティブです。デバイスがディスエーブルの場合、LBOピンはハイ・インピーダンスです。その切り替わりのスレッシュホールド電圧はLBIで500mVです。正常動作時、LBIに印加される電圧がスレッシュホールドより上の場合LBOはハイ・インピーダンスです。LBIの電圧が500mVより下に低下した時アクティブの“L”レベルになります。

検出回路が切り替わるバッテリー電圧はLBIピンに接続される抵抗デバイダによりプログラムすることができます。抵抗デバイダはバッテリー電圧を500mVの電圧レベルに分圧し、次にその電圧はLBIスレッシュホールド電圧と比較されます。LBIピンは10mVの固有のヒステリシスがあります。LBIスレッシュホールドのプログラミングの詳細については“アプリケーション情報”の項を参照してください。ロー・バッテリー検出回路を使用しない場合は、LBIピンはGND(またはVBAT)に接続しなければならず、一方LBOピンは未接続にしておくことができます。LBIピンをフローティングにしてはいけません。

低EMIスイッチ

このデバイスは、コンバータが不連続モードになった時通常SWノードに現れるリングングを除去する回路を内蔵しています。この場合、インダクタに流れる電流はゼロに減少し、整流PMOSスイッチは出力キャパシタからバッテリーに戻ってくる逆電流を防止するためオフになります。半導体とインダクタの寄生成分に貯えられている残留エネルギーにより、SWピンにリングングが生じます。内蔵のアンチリングング・スイッチがこの電圧をVBATにクランプするため、リングングが減少します。

アプリケーション情報

設計手順

TPS6102x DC/DCコンバータは、標準端子電圧が0.9Vから6.5Vの1セルから最大3セルまでのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリーを電源とするシステム向けの製品です。このコンバータは、また、標準電圧が2.5Vから4.2Vの1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマーを電源とするシステムにも使用することができます。さらに、標準出力電圧が0.9Vから6.5Vのその他の電圧源もTPS6102xが使われるシステムに電源を供給することができます。

出力電圧のプログラミング

TPS61020 DC/DCコンバータの出力電圧は外付けの抵抗デバイダにより可変で調整することができます。FBピンの標準電圧値は500mVです。出力電圧の推奨最大値は5.5Vにします。抵抗デバイダを流れる電流はFBピンに流れ込む電流の約100倍にします。FBピンに流れ込む電流の標準値は0.01μAで、R4端の電圧は500mVです。この2つの値をもとに、デバイダ電流を1μAまたはそれより高く設定するためにはR4の推奨値は500kΩより小さくしなければなりません。内部の補償回路により、この抵抗値は200kΩ以内でなければなりません。このことから、抵抗R3の値は、必要とされる出力電圧(V_O)により、以下の式(1)を使って計算できます。

$$R3 = R4 \times \left(\frac{V_O}{V_{FB}} - 1 \right) = 180 \text{ k}\Omega \times \left(\frac{V_O}{500 \text{ mV}} - 1 \right) \quad (1)$$

例として、3.3Vの出力電圧が必要とされる場合、R3には1.0MΩの抵抗が選択されます。何らかの理由でR4に200kΩよりかなり小さい値が選択されたとすると、出力電圧のレギュレーションが不安定である場合には、R3と並列に容量を付加することを推奨します。必要とされる容量値は以下の式(2)を使って簡単に計算できます。

$$C_{\text{par}R3} = 20 \text{ pF} \times \left(\frac{200 \text{ k}\Omega}{R4} - 1 \right) \quad (2)$$

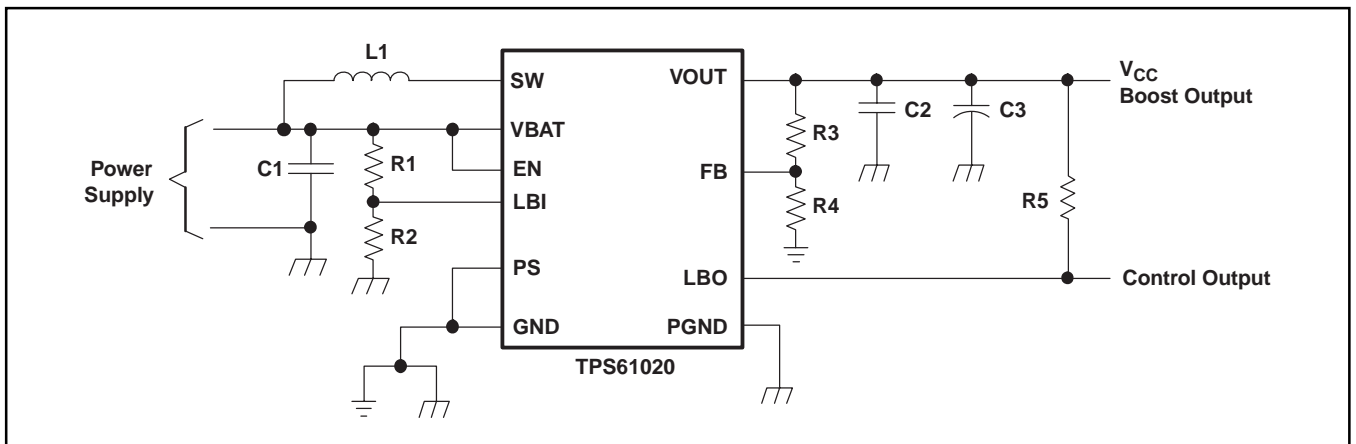


図21. Typical Application Circuit for Adjustable Output Voltage Option

LBI/LBOスレッショールド電圧のプログラミング

抵抗デバイダを流れる電流はLBIピンに流れ込む電流の約100倍にします。LBIピンに流れ込む電流の標準値は0.01 μ Aで、R2端の電圧はチップで生成される500mVの値をもつLBI電圧スレッショールドと等しくなります。従って、R2の推奨値は500k Ω 以内です。このことから、抵抗R1の値は、設定最小バッテリー電圧VBATにより、以下の式(3)を使って計算できます。

$$R1 = R2 \times \left(\frac{V_{BAT}}{V_{LBI} - \text{threshold}} - 1 \right) = 390 \text{ k}\Omega \times \left(\frac{V_{BAT}}{500 \text{ mV}} - 1 \right) \quad (3)$$

ロー・バッテリー・スーパーバイザの出力は、使用されているバッテリーの電圧がLBIのプログラムされたスレッショールド電圧より下に低下するとアクティブで“L”レベルになる簡素なオープン・ドレイン出力です。この出力には推奨値1M Ω のプルアップ抵抗が必要です。使用しない場合にはLBOピンはフローティングにしておくかまたはGNDに接続します。

インダクタの選択

ブースト・コンバータは変換時エネルギーを貯えるため通常2つの主要受動部品が必要です。つまり、ブースト・インダクタと出力にストレージ・キャパシタが必要となります。ブースト・インダクタを選択するには、選択した構成において起こり得るピーク・インダクタ電流をパワー・スイッチの電流制限スレッショールドより下に保持することを推奨します。例えば、TPS6102xのスイッチの電流制限スレッショールドは出力電圧が5Vの時1800mAです。インダクタとスイッチを流れる最大ピーク電流は、出力負荷、入力電圧(VBAT)、出力電圧(VOUT)に依存します。最大平均インダクタ電流は以下の式(4)を使って概算できます。

$$I_L = I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{BAT} \times 0.8} \quad (4)$$

例えば、出力電圧が3.3V、出力電流が200mAの場合、0.9Vの最小入力電圧の時少なくとも920mAの平均電流がインダクタを流れます。

インダクタを選択する際の2番目のパラメータはインダクタの設定電流リップルです。通常、望ましくは平均インダクタ電流の20%より小さいリップルで動作することです。リップルが小さいと出力電圧リップルやEMIだけでなくインダクタの磁気ヒステリシス損も低減します。しかし、同じように、負荷変化時のレギュレーション時間が増加します。さらに、インダクタが大きいとシステムの総コストも増大します。これらのパラメータにより以下の式(5)を使ってインダクタの値を計算することができます。

$$L = \frac{V_{BAT} \times (V_{OUT} - V_{BAT})}{\Delta I_L \times f \times V_{OUT}} \quad (5)$$

パラメータfはスイッチング周波数、 ΔI_L はインダクタのリップル電流、すなわち20% $\times I_L$ です。この例では、求められたインダクタ値は5.5 μ Hです。この計算値と上記電流の計算結果により、適切なインダクタを選択することが可能となります。標準的なアプリケーションでは6.8 μ Hのインダクタを推奨します。このデバイスは2.2 μ Hから22 μ Hの間のインダクタンス値で動作するように最適化されています。それでも、アプリケーションによってはこれより大きなインダクタンス値での動作も可能です。その場合は安定性の解析を詳細に行うことを推奨します。負荷過渡応答と回路の損失により式(5)で概算されるより大きな電流になる可能性

があることに注意する必要があります。また、磁気ヒステリシス損や銅損により生じるインダクタの損失も回路の総効率にとって重要なパラメータです。

以下の各サプライヤのインダクタ・シリーズ製品がTPS6102xコンバータとともに使用されています。

ベンダー	インダクタ・シリーズ名
Sumida	CDRH4D28
	CDRH5D28
Würth Elektronik	7447789
	744042
EPCOS	B82462-G4
Cooper Electronics Technologies	SD25
	SD20

表3. インダクタ・リスト

キャパシタの選択

入力キャパシタ

レギュレータの過渡動作及び電源回路全体の動作を改善するため少なくとも10 μ Fの入力キャパシタを推奨します。0.1 μ Fのセラミック・キャパシタをセラミック・キャパシタまたはタンタル・キャパシタと並列にICに近づけて配置することを推奨します。

出力キャパシタ

出力キャパシタを規定するのに必要な主要パラメータはコンバータの最大許容出力電圧リップルです。このリップルは、キャパシタの2つのパラメータである、容量とESRで決まります。ESRをゼロと仮定して、規定したリップルに必要とされる最小容量を以下の式(6)を使って計算できます。

$$C_{\min} = \frac{I_{OUT} \times (V_{OUT} - V_{BAT})}{f \times \Delta V \times V_{OUT}} \quad (6)$$

パラメータfはスイッチング周波数、 ΔV は最大許容リップルです。

リップル電圧を10mVに選択すると、最小容量24 μ Fが必要となります。総リップルは出力キャパシタのESRによりこれより大きくなります。このさらなるリップル成分は式(7)を使って計算できます。

$$\Delta V_{ESR} = I_{OUT} \times R_{ESR} \quad (7)$$

80m Ω の低ESRのタンタル・キャパシタを使用した結果追加されるリップルは16mVです。総リップルは容量により生じるリップルとキャパシタのESRにより生じるリップルの合計です。この例では、総リップルは26mVです。さらに別のリップルが負荷過渡により生じます。このことは、出力キャパシタはインダクタの充電フェーズ時十分に負荷に電流を供給できる能力が必要であるということを意味しています。出力容量の適正値は負荷変化時の負荷過渡の速度と負荷電流に依存します。最小容量の計算結果24 μ Fと負荷過渡を考慮すると、推奨出力容量値は47 μ Fから100 μ Fの範囲です。経済的理由により、これは通常はタンタル・キャパシタになります。従って、コントロール・ループは30m Ω より大きなESRをもつ出力キャパシタを使用することに対して最適化されています。出力キャパシタの最小値は10 μ Fです。

小信号安定性

セラミックのような低いESRの出力キャパシタを使用する場合には、可変出力電圧バージョンを推奨します。ESRの不足はフィードバック・デバイダで補償することができます。一般的に4.7pF以内のキャパシタをR3に並列にすると低ESRの出力キャパシタで小信号安定性を得るのに役立ちます。より詳細の解析には、式(8)で求められる誤差増幅器とレギュレータの小信号伝達関数を使用することができます。

$$A_{REG} = \frac{d}{V_{FB}} = \frac{4 \times (R3 + R4)}{R4 \times (1 + i \times \omega \times 0.9 \mu s)} \quad (8)$$

レイアウトについての考察

すべてのスイッチング電源では、特に高ピーク電流及び高スイッチング周波数時レイアウトは設計での重要なステップとなります。レイアウトが注意深く行われていないと、レギュレータは

EMI問題はもとより安定性の問題も生じることがあります。従って、主要な電流パスや電源グランド・トラックには広く短い配線を使用してください。入力キャパシタ、出力キャパシタ、インダクタはできるだけICの近くに置かなければなりません。グランド・ノイズの影響を最小限に抑えるため、電源グランドには共通のグランド・ノード、コントロール・グランドにはこれとは別のノードを使用してください。これらのグランド・ノードはICのグランド・ピンの1つに近い場所で接続してください。

フィードバック・デバイダはICのコントロール・グランド・ピンにできるだけ近い場所に配置しなければなりません。コントロール・グランドを適切に配置するには、配線を短くし、さらに電源グランドの配線から分離することを推奨します。このことにより、電源グランドの電流とコントロール・グランドの電流の重なり合いにより起こり得るグランド・シフトの問題が避けられます。

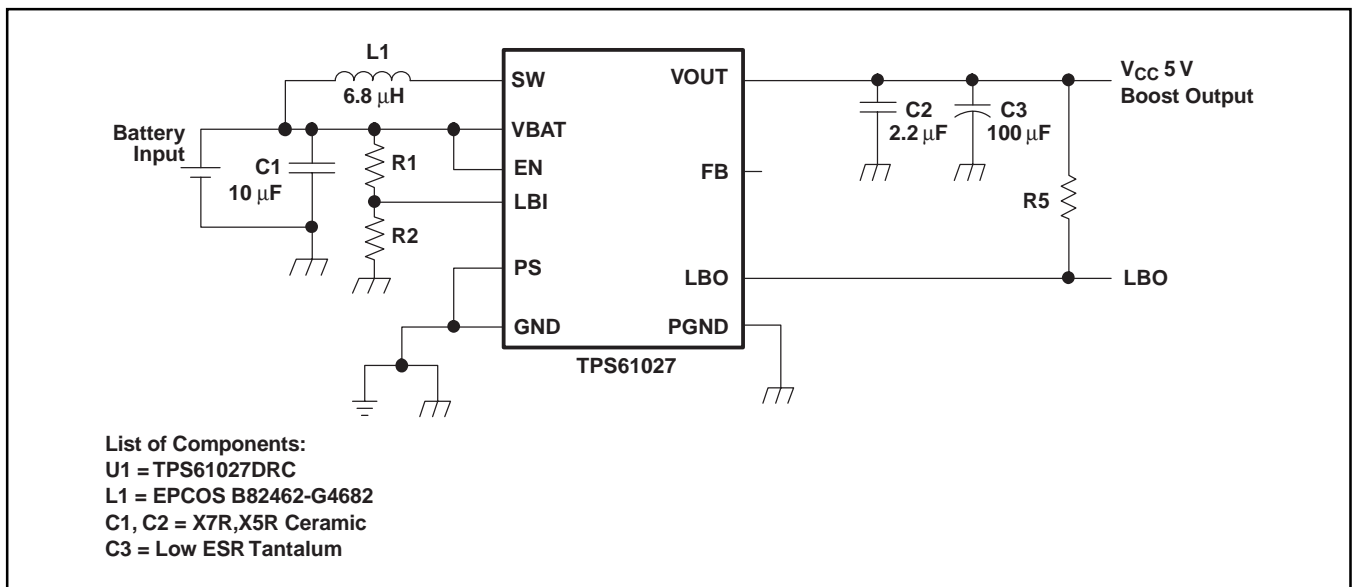


図22. Power Supply Solution for Maximum Output Power Operating from a Single Alkaline Cell

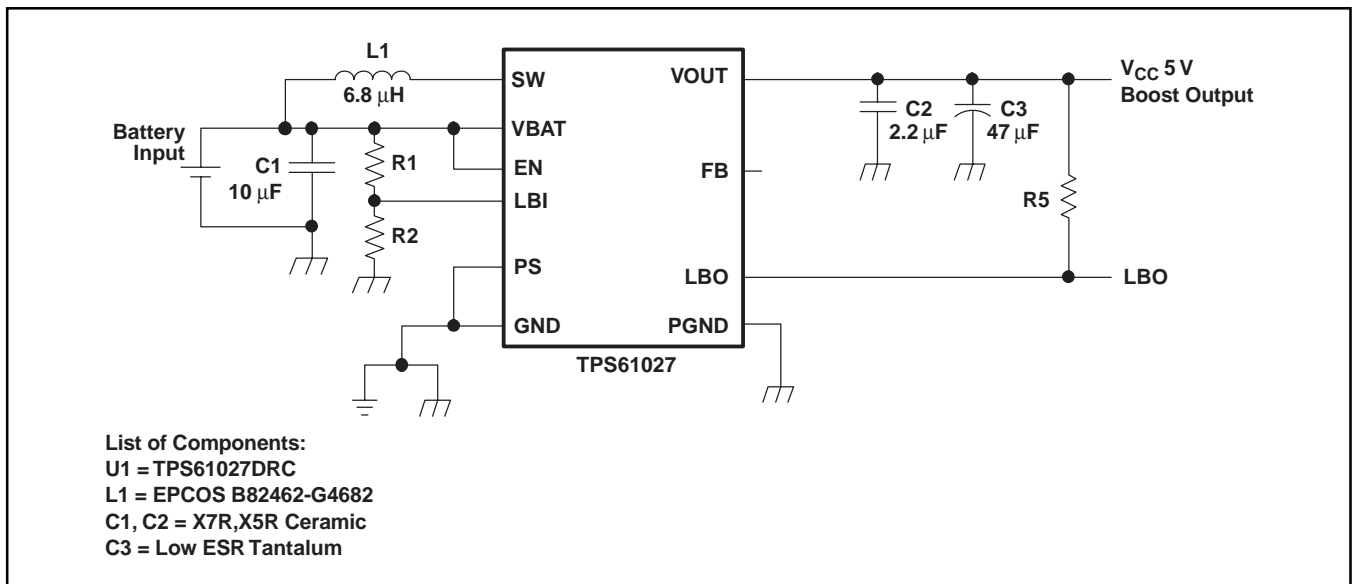
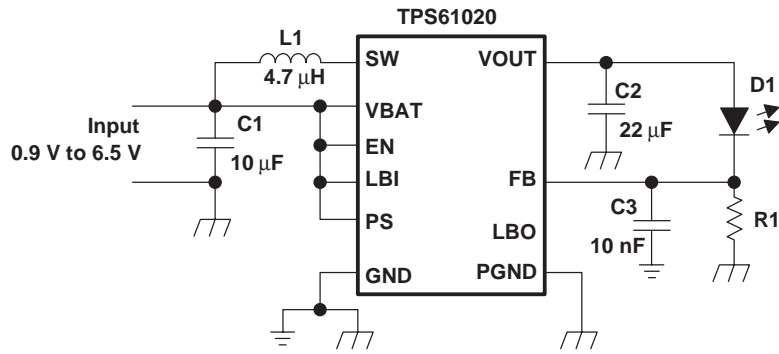
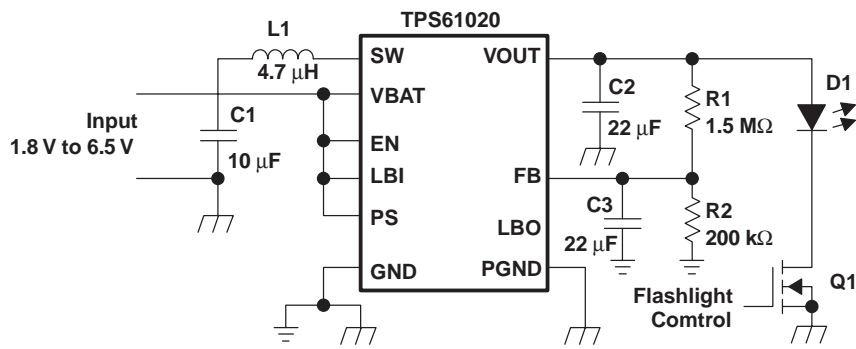


図23. Power Supply Solution for Maximum Output Power Operating from a Dual/Triple Alkaline Cell or Single Li-Ion Cell



- List of Components:**
 U1 = TPS61020DRC
 L1 = Sumida CDRH2D16-4R7
 C1, C2, C3 = X7R, X5R Ceramic
 D1 = White LED

24. Power Supply Solution for Powering White LED's in Lighting Applications



- List of Components:**
 U1 = TPS61020DRC
 L1 = TDK VLF3010AT 4R7MR70
 C1, C2, C3 = X7R, X5R Ceramic
 D1 = OSRAM LWW57G
 Q1 = Vishay SI1012R

25. Simple Power Supply Solution for Powering White LED Flashlights

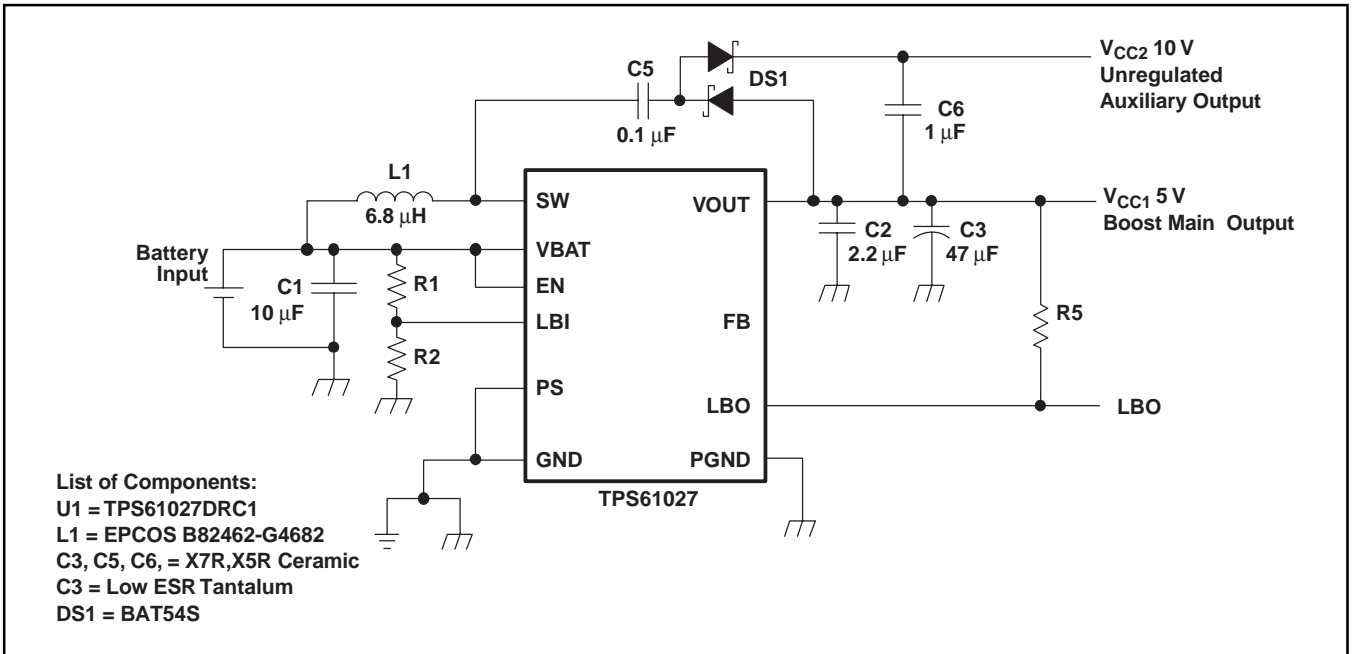


Figure 26. Power Supply Solution With Auxiliary Positive Output Voltage

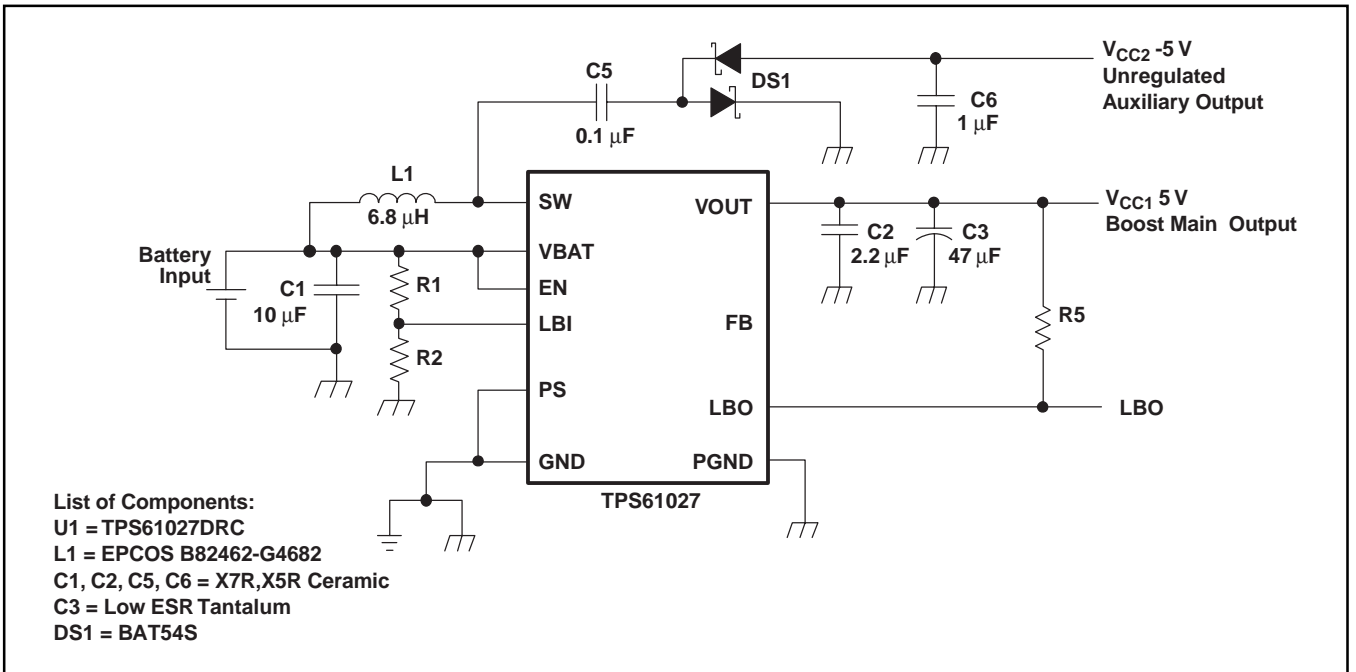


Figure 27. Power Supply Solution With Auxiliary Negative Output Voltage

熱情報

薄型、狭ピッチの表面実装パッケージICを使用する際には一般的に消費電力への特別な注意が必要です。熱結合、エアフロー、追加ヒートシンクと対流面、他の発熱部品の存在といった多くのシステム依存の問題が与えられた部品の消費電力リミットに影響を及ぼします。熱特性を向上させる基本的な3つの方法を以下にあげます。

- PCB設計において基板の熱抵抗を下げるにより電力消費能力を改善する
- 部品のPCBへの熱結合を改善する
- システムにエアフローを導入する

TPS6102xデバイスの推奨最大接合部温度(T_J)は125 °Cです。3mm x 3mm の10ピンQFNパッケージ(DRC)の熱抵抗 $R_{\theta JA}$ はPowerPADがはんだ付けされた場合48.7 °C/Wです。レギュレータの動作規定は最大周囲温度 $T_A = 85$ °Cで保証されています。従って、最大消費電力は約820mWです。アプリケーションの最大周囲温度がこれより低ければ、より大きな電力を消費することができます。

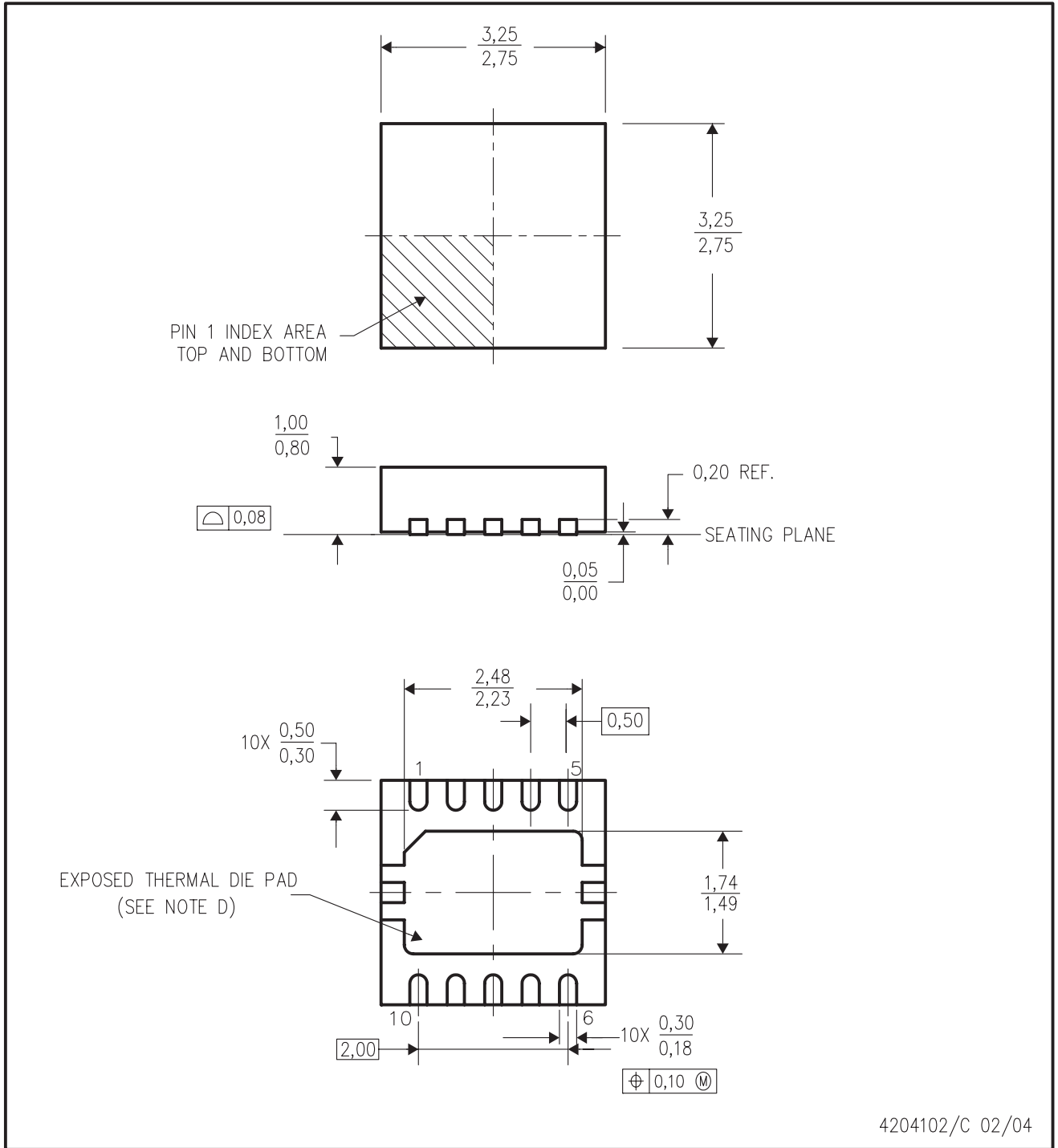
$$P_{D(MAX)} = \frac{T_{J(MAX)} - T_A}{R_{\theta JA}} = \frac{125\text{ °C} - 85\text{ °C}}{48.7\text{ °C/W}} = 820\text{ mW} \quad (9)$$

MECHANICAL DATA

DRC (S-PDSO-N10)

CUSTOM DEVICE

PLASTIC SMALL OUTLINE



- 注 A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
 B. 図は予告なく変更することがあります。
 C. スモール・アウトライン・ノーリード(SON)パッケージ構造です。
 D. パッケージの熱特性はサーマル・ダイ・パッドを外部のサーマル・プレーンに接合することで改善されることがあります。

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社及びTexas Instruments Incorporated (以下TIといいます)は、TI所定の手続きに従い、あるいはお客様とTIとの間に取引契約が締結されている場合は当該契約条件に従い、その製品を変更し、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止することがありますので、お客様は、発注される前に、これから参照しようとする情報が最新かつ完全なものであることを確かなものとするため、最新版の情報を取得するようお勧めします。全ての製品は、お客様とTIとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示される保証、特許侵害、責任制限に関する条項を含むTIの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、その製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様書に対応した性能を有していること、またはお客様とTIとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様書に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TI製部品を使用しているお客様の製品についてはお客様が責任を負っています。

そのようなお客様の製品について想定されうる危険を最小のものとするため、製品固有の障害発生要因もしくは組み合わせによる障害発生要因を減らすための、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、製品の使用用途に関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TIは、その製品もしくはサービスが使用される、もしくは使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法をカバーしている、もしくはそれ等に関連している特許権、著作権、回路配置利用権、その他の知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾することは明示的にも黙示的にも保証も表示もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供しているということは、TIが当該製品もしくはサービスを承認、ライセンス、保証もしくは支持することを意味しません。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、且つその情報と結び付られた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加え、あるいはその一部のみ、表示もしくは複製することは当該情報に係るTI製品もしくはサービスに対して提供された全ての保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為であり、TIは、そのような使用については如何なる義務ないし責任も負うものではありません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他と異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、且つ不公正で誤認を生じさせる行為であり、TIは、そのような使用については如何なる義務ないし責任も負うものではありません。

なお、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社半導体集積回路製品販売用標準契約約款もご覧下さい。

<http://www.tij.co.jp/jsc/docs/stdterms.htm>

Copyright © 2004, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位 (外装から取り出された内装及び個装) 又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で (導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使用すること。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

- 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

- 梱包品 (外装、内装、個装) 及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質 (硫黄、塩素等ハロゲン) のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上